

杭州士兰微电子股份有限公司

SiC 项目进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）加快推进 SiC 芯片技术研发及量产，具体进展如下：

2024 年，公司加快推进“士兰明镓 6 英寸 SiC 功率器件芯片生产线”项目的建设。截至目前，士兰明镓已形成月产 9,000 片 6 吋 SiC MOS 芯片的生产能力。基于公司自主研发的 II 代 SiC-MOSFET 芯片生产的电动汽车主电机驱动模块在 4 家国内汽车厂家累计出货量 5 万只，客户端反映良好，随着 6 吋 SiC 芯片生产线产能释放，已实现大批量生产和交付。目前，公司已完成第 IV 代平面栅 SiC-MOSFET 技术的开发，性能指标接近沟槽栅 SiC 器件的水平。第 IV 代 SiC 芯片与模块已送客户评测，基于第 IV 代 SiC 芯片的功率模块预计将于 2025 年上量。

同时，公司加快推进“士兰集宏 8 英寸 SiC 功率器件芯片生产线”项目的建设。截至 2024 年底，士兰集宏 8 吋 SiC mini line 已实现通线，公司 II 代 SiC 芯片已在 8 吋 mini line 上试流片成功，其参数与公司 6 吋产品匹配，良品率明显高于 6 吋。士兰集宏主厂房及其他建筑物已全面封顶，正在进行净化装修，预计将在 2025 年 4 季度实现全面通线并试生产，以赶上 2026 年车用 SiC 市场的快速成长。

当前，在国家政策持续支持，以及下游电动汽车、新能源、算力和通讯等行业快速发展、芯片国产替代进程明显加快的大背景下，士兰微电子将加快实施“一体化”战略，持续加大对模拟电路、功率半导体、MEMS 传感器、包括 SiC、GaN 在内的第三代化合物半导体等方面的投入，大力推进系统创新和技术整合，积极拓展汽车、新能源、工业、通讯、大型白电、电力电子等中高端市场，不断提升产品附加值和产品品牌力，持续推动公司整体营收的较快成长和经营效益的提升，努力为国家集成电路产业发展做出贡献。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日